

テーマ情報 Theme information					Fタームデータ F-term data				
テーマ コード Theme code	解析停止 Deactivated	解析 タイプ Type	テーマ名 Theme name	FIカバー範囲 FI coverage	改正情報(メンテ内容等) Maintenance information	Fターム の有無 F-term existence	解析年範囲 Assigned period		再解析中 Under reassignm ent
							開始年 Start	終了年 End	
5F001	○		不揮発性半導体メモリ	(H01L29/78)	5F040→5F140				
5F002	○		電界効果トランジスタ(MOSを除く)	(H01L29/80)	5F102へ変更	○		1982	
5F003		F	バイポーラトランジスタ	H01L29/68-29/72@Z		○			
5F004		F	半導体のドライエッチング	H01L21/302-21/302,400;21/461	リスト微修正(H14)	○			
5F005		F	サイリスタ	H01L29/74-29/747,301		○			
5F011	○				5E311へ変更				
5F012	○				5E312へ変更				
5F013	○				5E313へ変更				
5F014	○				5E314へ変更				
5F015	○				5E315へ変更				
5F017	○				5E317へ変更				
5F019	○				5E319へ変更				
5F021	○				5E321へ変更				
5F022	○				5E322へ変更				
5F031	○	F	ウエハ等の容器, 移送, 固着, 位置決め等	(H01L21/68-21/68@Z)	リスト再作成(H10)、5F131へ変更(H23)	○	1988		
5F032		部分F	素子分離	H01L21/70-21/76@Z	ターム名の変更、付与マニュアルの変更、階層の変更(H16)	○			
5F033		F	半導体集積回路装置の内部配線	H01L21/88-21/90@Z	リスト再作成(H10)、1988年以降に発行された文献を解析対象としている	○	1988		
5F034		FI	半導体または固体装置のマウント	H01L23/12-23/14@Z					
5F035		FI	半導体又は固体完全装置の支持	H01L23/32-23/32@Z	FI化(H05)	○		1993	
5F036	○	F	半導体又は固体装置の冷却等	(H01L23/34-23/46@Z)	5F136へ変更(H16)	○			
5F037		FI	半導体または固体装置の組立体	H01L25/00-25/16@Z;H10B80/00					
5F038		F	半導体集積回路	H01L27/04-27/04@Z		○			
5F039		FI	本体に特徴のある半導体装置	H01L29/00-29/06;29/06,601-29/38	5F139へ分割(H26)				
5F040	○		絶縁ゲート型電界効果トランジスタ	(H01L29/76;29/78-29/78,301@Z)	5F140へ変更(H12)	○		2000	
5F041	○	F	発光ダイオード	(H01L33/00-33/00,450)	5F141,5F142へ分割(H23)	○			
5F042		FI	拡散	H01L21/22-21/24;21/38-21/40					
5F043		F	ウェットエッチング	H01L21/306-21/308@Z;21/465-21/467		○			

5F044		部分F	ボンディング	H01L21/447-21/449;21/60-21/607@Z	4M105,4M116,5F044,5F062統合(H10)、解析要否変更(H14)	○			
5F045		F	気相成長(金属層を除く)	H01L21/205;21/31-21/31@Z;21/365;21/469;21/86	リスト再作成(H09)、1989年以降に発行された文献を解析対象としている	○	1989		
5F046	○	部分F	半導体の露光(電子、イオン線露光を除く)	(H01L21/30-21/30,531@Z;21/30,561-21/30,579;21/46)	5F146へ変更(H22)	○			
5F047		部分F	ダイボンディング	H01L21/52-21/52@Z;21/58		○			
5F048		F	MOSIC, バイポーラ・MOSIC	H01L27/06,102-27/06,331;27/07,102;27/085-27/092@Z;27/118;27/118,102	ターム名の変更、付与マニュアルの変更(H16)	○			
5F049	○	F	受光素子3(フォトダイオード・Tr)	(H01L31/10-31/10@Z)	リスト再作成(H10)、5F849へ統合(H26)	○			
5F050		FI	圧電、電歪、磁歪装置	H10N30/00-39/00					
5F051	○	F	光起電力装置	(H01L31/04-31/06)	5F151へ変更(H21)	○			
5F052	○	F	再結晶化技術	(H01L21/18-21/20;21/34-21/36;21/84)	5F152へ変更(H16)	○			
5F053		F	半導体装置を構成する物質の液相成長	H01L21/208-21/208@Z;21/368-21/368@Z		○			
5F054		FI	アニール	H01L21/26-21/268@Z;21/322-21/326;21/42-21/428;21/477-21/479					
5F056		F	電子ビーム露光	H01L21/30,541-21/30,551		○			
5F057		F	半導体の機械的処理	H01L21/304-21/304,631;21/463	5F057へ分割(H15再編)、FIテーマのFターム化(H21)	○			
5F058		F	絶縁膜の形成	H01L21/312-21/32;21/47-21/475		○			
5F059		FI	半導体装置の製造、組立て	H01L21/48-21/50@Z;21/96-21/98					
5F061		F	半導体または固体装置の封緘、被覆の形成	H01L21/56-21/56@Z		○			
5F062	○		圧着ボンディング、超音波ボンディング	(H01L21/447,21/449,21/603-21/607)	5F044に統合(H10)			1998	
5F063		F	ダイシング	H01L21/78-21/80	FIテーマのFタームテーマ化(H24)	○			
5F064		F	ICの設計・製造(配線設計等)	H01L21/82-21/82@Z		○			
5F065		FI	半導体容器とその封止	H01L21/54;23/00-23/10@Z;23/16-23/26					

5F066		FI	ダイオード、トランジスタのリードフレーム	H01L23/48-23/48@Z					
5F067		F	IC用リードフレーム	H01L23/50-23/50@Z		○			
5F068		FI	チップ間配線	H01L23/52-23/54	テーマ名変更(H04)				
5F069		FI	温度補償回路等	H01L23/56-23/56@Z	テーマ名変更(H04)				
5F070		FI	メーザ	H01S1/00-1/06					
5F071		F	レーザ(1)	H01S3/03-3/038@Z;3/097-3/0979;3/104;3/134;3/22-3/227		○			
5F072	○	F	レーザ(2)	(H01S3/00-3/02;3/04-3/095@Z;3/098-3/102;3/105-3/131;3/136-3/20@Z;3/23-4/00)	5F172へ変更(H15)	○			
5F073	○	F	半導体レーザ	(H01S5/00-5/50,630)	5F173へ変更(H15)	○			
5F080		FI	三次元集積回路	H01L27/00,301-27/00,301@Z					
5F081		FI	ハイブリッド IC	H01L27/00;27/01-27/02;27/13					
5F082		部分F	バイポーラIC	H01L27/06-27/06,101@Z;27/07-27/07,101;27/08-27/082@Z;27/095-27/098;27/118,101		○			
5F083		F	半導体メモリ	H01L27/10-27/105;H10B10/00-53/50;63/00-69/00;99/00-99/00,495	リスト再作成(H09)、4M119へ分割(H17)、1990年以降に発行された文献を解析対象としている	○	1990		
5F084		FI	SOI, アクティブマトリクス、SOS	H01L27/12-27/12@Z					
5F086		FI	動作に特徴のある半導体	H01L29/66-29/66@Z					
5F087		FI	ダイオード	H01L29/86-29/96					
5F088	○	F	受光素子1(共通事項、放射線検出)	(H01L31/00-31/02@Z;31/08-31/08@Z)	5F849へ統合(H26)	○			
5F089	○	F	フォトカプラ・インタラプタ	(H01L31/12-31/12@Z)	5F889へ統合(H26)	○			
5F090	○	FI	光-光変換装置	(H01L31/14-31/18)	5F849、5F889へ統合(H26)				
5F091		FI	熱電素子	H10N10/00-19/00					
5F092		F	ホール/MR素子	H01L29/82-29/82@Z;H10N50/00-59/00	FIテーマのFターム化(H17)	○			
5F093		FI	オブシンスキー素子	H01L21/62;H10N70/00-79/00					
5F094		FI	ガン効果素子	H10N80/00-89/00					
5F095		FI	薄膜、厚膜装置	H10N97/00-99/00					
5F096	○	FI	有機半導体材料						
5F097		FI	光集積回路	H01L27/15-27/15@Z					

5F101		F	不揮発性半導体メモリ	H01L29/78,371	付与マニュアル修正	○			
5F102		F	接合型電界効果トランジスタ	H01L29/80-29/80@Z	旧5F002	○			
5F103		F	半導体装置を構成する物質の物理的析出	H01L21/203-21/203@Z;21/363		○			
5F107		FI	パンプ電極	H01L21/92-21/92,621@Z					
5F110		F	薄膜トランジスタ	H01L29/78,611-29/78,627@Z	リスト作成(H10)、1989年以降に発行された文献を解析対象としている	○	1989		
5F111		FI	縦型MOSTランジスタ	H01L29/78,651-29/78,658@Z					
5F117		FI	半導体装置の製造処理一般	H01L21/00-21/16					
5F121		FI	電子デバイス1						
5F122		FI	電子デバイス2						
5F123		FI	電子デバイス3						
5F131		F	ウエハ等の容器, 移送, 固着, 位置決め等	H01L21/68-21/68@Z	リスト再作成旧5F031(H23)、1988年以降に発行された文献を解析対象としている	○	1988		
5F136		F	半導体または固体装置の冷却等	H01L23/34-23/46@Z	リスト再作成旧5F036(H16)	○			
5F137		FI	電子デバイス4						
5F138		FI	電子デバイス5						
5F139		FI	耐圧構造	H01L29/06,301-29/06,301@Z	5F039から分割(H26)				
5F140		部分F	絶縁ゲート型電界効果トランジスタ	H01L29/76;29/78-29/78,301@Z	リスト再作成旧5F040(H12)、1991年以降に発行された文献を解析対象としている	○	1991		
5F141	○	F	LED素子(パッケージ以外)	(H01L33/00;33/00@J-33/00@K;33/00@Z-33/00,310)	5F041から分割,リスト再作成(H23)、5F241へ変更(H26)	○			
5F142		F	LED素子のパッケージ	H01L33/00@H;33/00@L;33/48-33/64	5F041から分割,リスト再作成(H23)	○			
5F146		部分F	半導体の露光(電子、イオン線露光を除く)	H01L21/30-21/30,531@Z;21/30,561-21/30,579;21/46	リスト部分改訂旧5F046(H22)	○			
5F148		FI	電子デバイス6						
5F149		F	受光素子	H01L31/00-31/02@Z;31/08-31/10@Z;31/18;H10K30/60-30/65;39/30	リスト再作成旧5F849(R4)、再解析予定または再解析中	○			○
5F151	○	F	光起電力装置	(H01L31/04-31/06,600;H02S10/00-10/40;30/00-99/00;H10K30/00;30/50-30/57;39/00-39/18)	リスト部分改訂旧5F051(H21)、5F251へ変更(R4)	○			
5F152		F	再結晶化技術	H01L21/18-21/20;21/34-21/36;21/84	リスト再作成旧5F052(H16)	○			

5F157		F	半導体の洗浄、乾燥	H01L21/304,641-21/304,651@Z	5F057から分割(H15)、テーマ名修正(H16)、FIテーマのFターム化(H18)	○			
5F172		F	レーザ(2)	H01S3/00-3/02;3/04-3/0959;3/10-3/102;3/105-3/131;3/136-3/213;3/23-4/00	リスト再作成旧5F072(H15)	○			
5F173		F	半導体レーザ	H01S5/00-5/50,630	リスト再作成旧5F073(H15)	○			
5F182		FI	電子デバイス7						
5F184		FI	電子デバイス8						
5F188		FI	光起電力装置・受光素子共通細部	H10K30/10-30/40;30/80-30/89;39/36-39/38					
5F196		FI	有機トランジスタ	H10K10/00-19/80					
5F197		FI	LED素子の集積装置、組立体、製造方法」						
5F211		FI	電子デバイス9						
5F241		F	LED素子(パッケージ以外)	H01L33/00;33/00@J-33/00@K;33/00@Z-33/46	リスト再作成旧5F141(H26)	○			
5F251		F	光起電力装置	H01L31/04-31/06,600;H02S10/00-10/40;30/00-99/00;H10K30/00;30/50-30/57;39/00-39/18	リスト再作成旧5F151(R4)、再解析予定または再解析中	○			○
5F333	○				5E333に変更				
5F334	○				5E334に変更				
5F335	○				5E335に変更				
5F336	○				5E336に変更				
5F337	○				5E337に変更				
5F338	○				5E338に変更				
5F339	○				5E339に変更				
5F849	○	F	受光素子	(H01L31/00-31/02@Z;31/08-31/10@Z;31/18;H10K30/60-30/65;39/30)	5F049、5F088、5F090(一部)統合、リスト再作成(H26)、再解析中、5F149へ変更(R4)	○			
5F889		F	フォトカプラ・インタラプタ・光光変換装置	H01L31/12-31/16@Z	5F089、5F090(一部)統合、リスト再作成(H26)	○			